



2SB1182 (3CG1182)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途：用于中功率放大。

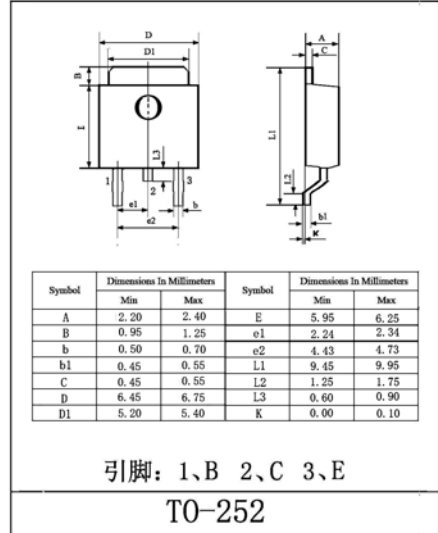
Purpose: Medium power amplifier applications.

特点：饱和压降低，与 2SD1758 (3DG1758) 互补。

Features: Low  $V_{CE(sat)}$ , complements the 2SD1758 (3DG1758).

极限参数/Absolute maximum ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
$V_{CB0}$	-40	V
$V_{CE0}$	-32	V
$V_{EB0}$	-5.0	V
$I_C$	-2.0	A
$I_{CM}$	-3.0	A
$P_C$ ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	10	W
$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$	-55~150	$^\circ\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
$V_{CB0}$	$I_C=-50\ \mu\text{A}$ $I_E=0$	-40			V
$V_{CE0}$	$I_C=-1.0\text{mA}$ $I_B=0$	-32			V
$V_{EB0}$	$I_E=-50\ \mu\text{A}$ $I_C=0$	-5.0			V
$I_{CB0}$	$V_{CB}=-20\text{V}$ $I_E=0$			-1.0	$\mu\text{A}$
$I_{EB0}$	$V_{EB}=-4.0\text{V}$ $I_C=0$			-1.0	$\mu\text{A}$
$h_{FE}$	$V_{CE}=-3.0\text{V}$ $I_C=-0.5\text{A}$	82		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-2.0\text{A}$ $I_B=-0.2\text{A}$		-0.5	-0.8	V
$f_T$	$V_{CE}=-5.0\text{V}$ $I_C=-0.5\text{A}$ $f=30\text{MHz}$		100		MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		50		pF

$h_{FE}$  分档/ $h_{FE}$  Classifications:

$h_{FE(1)}$ 分档 $h_{FE(1)}$ Classifications	P	Q	R
$h_{FE(1)}$ 范围 $h_{FE(1)}$ Range	82~180	120~270	180~390



# 2SB1182 (3CG1182)

